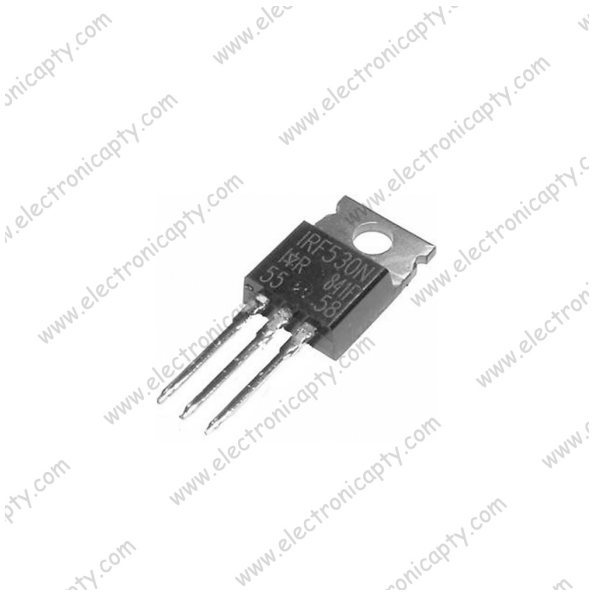
Transistor MOSFET IRF530 100V 14A

Codigo: **111398**



Descripción

Transistor mosfet IRF530 de canal N que ofrece la mejor combinación de conmutación rápida, el diseño de este dispositivos esta echo para uso rudo, baja resistencia y costo-efectividad.

- Área de operación segura extendida
- Corriente de fuga más baja (10A máximo en VDS = 100V)
- Baja RDS (ON) (0.092? tipico)
- ± 20V Tensión de puerta a fuente
- 6..5 ° C / W Resistencia térmica, unión al ambiente
- 2.74 ° C / W Resistencia térmica, unión a caja
- Aplicaciones: Administración de Potencia

Información Básica

- Polaridad: Canal N
- Intensidad drenador continua Id: 14 A
- Tensión drenaje-fuente Vds: 100 V
- Resistencia de activación Rds(on): 110mohm
- Tensión Vgs de medición Rds(on): 100 V
- Tensión umbral Vgs: 2 V
- Disipación de potencia Pd: 55 W
- Temperatura de trabajo mínima: -55 °C
- Temperatura de trabajo máxima: 175°C
- Encapsulado TO-220
- 3 pines